

**Verwendung:** Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor für den Einsatz als Schalttransistor in der Datenverarbeitungsindustrie

**SS 120\***

**Abmessungen:** Bauform B 3/25 – 3a,

TGL 11 811

Kollektor am Gehäuse

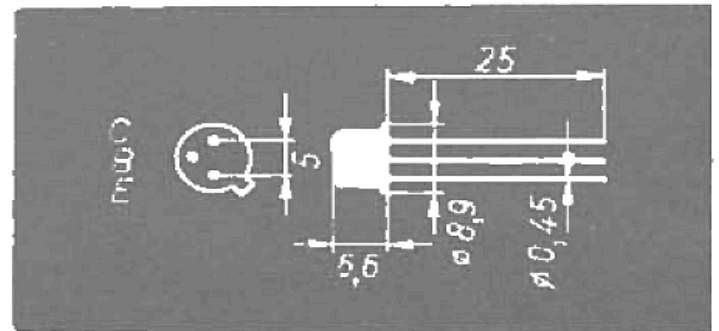
Masse 0,5 g

**Zulässige Höchstwerte bei  $\vartheta_{jmax}$**

$U_{CBO} = 60 \text{ V}$        $I_C = 500 \text{ mA}$

$U_{CEO} = 40 \text{ V}$        $P_{tot} = 700 \text{ mW}$

$U_{EBO} = 5 \text{ V}$        $\vartheta_{jmax} = 200 \text{ °C}$



	Min.	Typ	Max.	Meßbedingungen
<b>Sättigungsspannung</b>				
$U_{CEsat}$		1,0 V		$I_C = 500 \text{ mA}, I_B = 50 \text{ mA}$
$U_{BEsat}$		1,5 V		$I_C = 500 \text{ mA}, I_B = 50 \text{ mA}$
<b>h-Parameter</b>				
$h_{21e}$	10			$I_C = 500 \text{ mA}$
<b>Schaltzeiten</b>				
$t_{on}$		50 ns		$I_C = 500 \text{ mA}$
$t_{off}$		100 ns		$I_C = 500 \text{ mA}$

\* In Entwicklung – vorläufige Kenndaten